

2SB1463

Silicon PNP epitaxial planer type

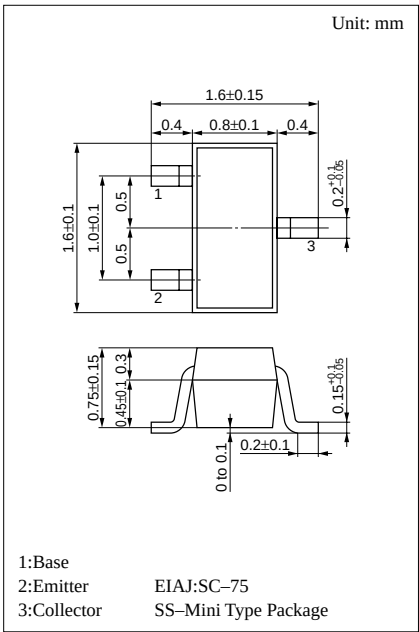
For high breakdown voltage low-noise amplification
Complementary to 2SD2240

■ Features

- High collector to emitter voltage V_{CEO} .
- Low noise voltage NV.
- SS-Mini type package, allowing downsizing of the equipment and automatic insertion through the tape packing and the magazine packing.

■ Absolute Maximum Ratings (Ta=25°C)

Parameter	Symbol	Ratings	Unit
Collector to base voltage	V_{CBO}	-150	V
Collector to emitter voltage	V_{CEO}	-150	V
Emitter to base voltage	V_{EBO}	-5	V
Peak collector current	I_{CP}	-100	mA
Collector current	I_C	-50	mA
Collector power dissipation	P_C	125	mW
Junction temperature	T_j	125	°C
Storage temperature	T_{stg}	-55 ~ +125	°C



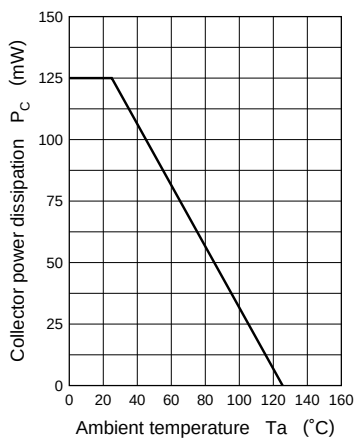
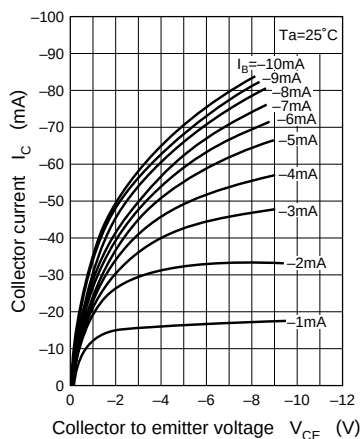
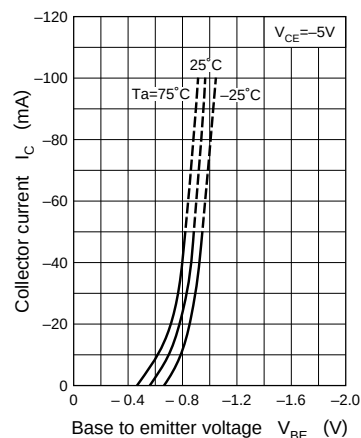
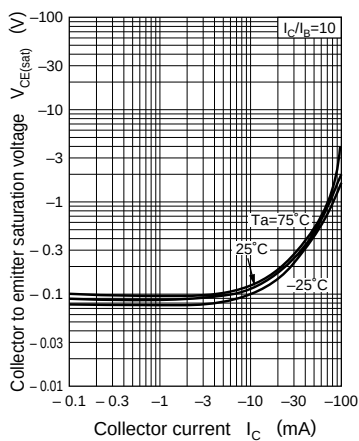
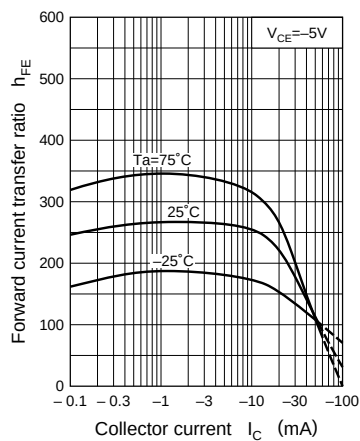
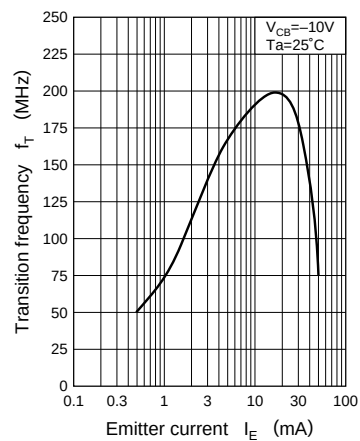
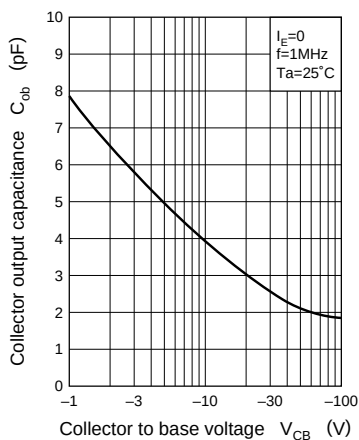
Marking symbol : I

■ Electrical Characteristics (Ta=25°C)

Parameter	Symbol	Conditions	min	typ	max	Unit
Collector cutoff current	I_{CBO}	$V_{CB} = -100V, I_E = 0$			-1	μA
Collector to emitter voltage	V_{CEO}	$I_C = -100\mu A, I_B = 0$	-150			V
Emitter to base voltage	V_{EBO}	$I_E = -10\mu A, I_C = 0$	-5			V
Forward current transfer ratio	h_{FE}^*	$V_{CE} = -5V, I_C = -10mA$	130		450	
Collector to emitter saturation voltage	$V_{CE(sat)}$	$I_C = -30mA, I_B = -3mA$			-1	V
Transition frequency	f_T	$V_{CB} = -10V, I_E = 10mA, f = 200MHz$		200		MHz
Collector output capacitance	C_{ob}	$V_{CB} = -10V, I_E = 0, f = 1MHz$		4		pF
Noise voltage	NV	$V_{CE} = -10V, I_C = -1mA, G_v = 80dB, R_g = 100k\Omega, \text{Function} = \text{FLAT}$		150		mV

* h_{FE} Rank classification

Rank	R	S	T
h_{FE}	130 ~ 220	185 ~ 330	260 ~ 450
Marking Symbol	IR	IS	IT

$P_C - T_a$  $I_C - V_{CE}$  $I_C - V_{BE}$  $V_{CE(sat)} - I_C$  $h_{FE} - I_C$  $f_T - I_E$  $C_{ob} - V_{CB}$ 

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9